<mark>গ্লানেপা</mark> (Korea)

EV Group announces NanoCleave layer release new technology revolutionizing 3D Integration for advanced packaging and transistor scaling – January 31, 2024

EVG introduced NanoCleave™, a revolutionary layer release technology for silicon that enables ultra-thin layer stacking for front-end processing, including advanced logic, memory and power device formation, as well as semiconductor advanced packaging. Enabling silicon carriers with inorganic release layers avoids these temperature and glass carrier compatibility issues. In addition, the nanometer precision of IR laser-initiated cleaving opens up the possibility of processing extremely thin device wafers without changing processes of record. Subsequent stacking of such thin device layers enables higher bandwidth interconnects and opens up new opportunities to design and segment dies for next-generation high-performance systems.



EVG는 코엑스에서 1월 31일부터 2월 2일까지 개최되는 SEMICON 코리아 2024 전시회에 참가 해 나노물리보 신기술을 소개한다. EVG 부스(부스 번호: D832, 3층)를 방문하면 EVG 임원들을 직접 만나서 이 혁신적인 적외선 레이저 이승 기술에 관해 논의할 수 있다.

◇ 3D 적층 및 후공정에서 실리콘 캐리어 사용의 이점

30 집작에서는 인터워넥션 대역폭이 점점 더 높아지면서 더 고성능의 시스템을 구현할 수 있 도록 박형 웨이퍼 공정을 위한 캐리어 기술이 중요하다. 이를 위해 기본 주두 기법들은 유리 배리어를 사용한다. 이 기법은 유기 접작제를 이용해 입시 본딩을 하서 디바이스 레이어를 형 성한 다음, 자외선(LM) 파장 레이저를 사용해서 접작제를 용해시키고 디바이스 레이어를 분리 한 후 최종 완성품 웨이퍼 상에 영구적으로 본딩한다. 하지만 유리 기판은 실리론 위주로 설계 된 반도제 제조 장비를 사용해서 처리하기가 까다롭고, 유리 웨이퍼를 처리할 수 있도록 업그 레이드하려면 비용이 많이 든다. 이뿐만 아니라 유기질 접착제는 동상적으로 300°C 이하 저리 온도로 사용이 제한되므로 후공정에 사용하기에 한계가 있다.

나노물리보 기술은 무기 박막을 활용하는 실리콘 캐리어를 사용할 수 있어 이런 온도 한계와 유리 캐리어의 호환성 이슈를 피할 수 있다. 또 IR 레이저를 사용해서 나노미터 정밀도로 물리 빙이 가능하므로 기존 공정을 변경하지 않고서 초박형 디바이스 웨이퍼를 처리할 수 있다. 이 렇게 만들어진 초박형 디바이스 레이어를 적중하면 더 높은 대역목의 인터커넥트를 구현할 수 있으며, 자세대 고성능 시스템을 위한 다이를 설계 및 세분화하기 위한 새로운 기회를 만들 수 있다.

◇ 차세대 트랜지스터 노드에 요구되는 새로운 레이어 이송 프로세스

트랜지스터 로드탭이 3m 이하 노드로 전쟁함에 따라 대립해 전원 레일 후면 전원 공급 네트 워크, 생보성 FEIT(FET), 2D 원자 채널 같은 새로운 아키텍자와 설계 핵심어 필요해졌다. 이런 모든 기법에는 극히 많은 소재의 레이어 이름이 오구된다. 설리를 캐리어와 무기 박막은 전 공 정 제조 플로를 위한 프로세스 정결성, 소재 호환성, 높은 처리 온도 요건을 지원한다. 지금까 전 설리는 캐리어가 그러인의 면다. 식각 공정을 거쳐서 완벽하게 제거됐다. 했지만. 이는 작업 오인 디바이스 레이어의 표면에 마이크를 대의 자이를 유발하므로 정단 트랜지스터 노드의 박형 레이어 점증에 사용하기에는 전합하지 않았다.

EVG의 새로운 나노물리보 기술은 적외선 레이저와 무기 박막을 사용하므로 실리콘상에서 나 노미터 정밀도로 레이저 디본링이 가능하다. 이는 정단 패키징 긍정에서 유리 기반을 사용할 필요가 없게 해 온도 한계와 유리 캐리어 호환성 문제를 피할 수 있게 해우면, 기존 긍정을 변 정하지 않고도 전 긍정에서 캐리어를 통해 포범했한 자륏수 마이크를 대 이하 레이어를 이슬 할 수 있다. 이런 나노미리대 정밀도를 지원하는 EVG의 새로운 프로세스는 더 얇은 디바이스 레이어와 패키지가 필요한 첨단 반도체 디바이스 로드랩의 요구를 충족하고 향상된 이중 집 적을 가능하게 하면, 유리 기단 사용 필요성 제거 및 박막 레이어 이슬 가능성을 통해 긍정 비 용을 접감할 수 있게 해된다.

EVG 그룹의 기술 이사 볼 린드네(Paul Lindner)는 '반도체 공정 노드를 축소하기가 감수록 더 복잡하고 어려워지고 있다. 공정 노드를 축소하려면 프로세스 허용 공자 또한 점점 더 줄어들 기 때문이다. 업계는 더 높은 집 전도와 더 높은 다하스 선수를 당성하기 위한 새로운 프로세 스와 집적 방법이 필요하다. 우리의 나노물리로 레이어 릴리즈 기술은 박형 레이어와 다이 적 중을 통한 반도체 크기 축소에서 게임 체인재가 될 것이며, 반도체업에서 가장 안박이 심한 요구 사장들은 하경할 잠재력을 갖추고 있다. 나노물리보는 표준 실리론 웨이퍼 및 웨이퍼 공 정들과 호환되는 유연하고 병용성이 뛰어난 레이어 릴리즈 기술을 통해 우리 고객이 점단 다 바이스 및 패키징 모드만을 실현할 수 있게 지원할 것이며, 고객들은 이 기술을 자신들의 기존 팬에 지체없이 통칭하고 시간과 비용을 점감할 수 있을 것이라고 말했다.

◇ 차별화된 IR 레이저 기술

EVS의 나노클리보 기술은 실리콘을 투과하는 고유의 파장을 사용해 실리콘 웨이퍼 뒷면을 적 외선 레이저에 노출시킨다. 표준 중작 공정으로 행성된 무기 박각이 R 광물 출수장으로써 전 전에 정밀하게 지정된 레이어는 연적으로 실리콘을 보리시킨다. 무기 박각을 사용함으로써 즉 더 정밀하고 않은 레이어를 사용할 수 있다.유기 접작제를 사용할 때수 마이크로대였던 것에 비해 수 나노미터(크로 알아짐). 뿐만 아니라 무기 박각은 고은 공정(최대 1000억으와 호환할 수 있으므로 에피텍시 중작 어닐리저럼 유기 접작제를 사용할 수 없는 많은 새로운 전 공정 애플 리케이션에서 레이어 이승을 가능하게 한다.

◇ 제품 공급

EVG의 나노물리브 기술은 현재 EVG 본사에서 데모가 가능하다.

최신기사

 "장난감인 줄"...호난투 여신에게 1억 다이아 시계 선물



민주, '선거제 당본' 결정 권한 이재명 대표에



http://www.mediadale.com/news/articleView.html?idxno=195988